### 平成19年度科学研究費補助金実績報告書(研究実績報告書)

1. 機 関 番 号	1 4 6 0 3	2. 研究機関名	奈良先端科学技術大学院大学

3. 研究種目名 若手研究(A) 4. 研究期間 平成 17 年度 ~ 平成 19年度

5. 課題番号 1 7 6 8 6 0 5 8

#### 7. 研究代表者

研 究 者 番 号	研究代表者名	所 属 部 局 名	職名
0 0 3 2 4 9 7 1	フリガナ タケダ, ヒ ロ ア キ 武田, 博明	物質創成科学研究科	助教

8. 研究分担者(所属研究機関名については、研究代表者の所属研究機関と異なる場合のみ記入すること。)

	研	究	者	番	号		研究分担者名	所属研究機関名・部局名	職	名
		į	į				フリカ゛ナ			
:	:	:	:	:	:	:				
į	j	;	į		-	į	フリカ゛ナ			
:	:	:	:	:	:	:				
		į	İ				フリカ゛ナ			
:	:	:	-		:	-				
1	1	į	İ		į		フリカ゛ナ 			
				:	:	:				
							フリカ゛ナ			
. !	1	1	1		1	1				

9. 研究実績の概要(国立情報学研究所でデータベース化するため、600字~800字で記入。図、グラフ等は記載しないこと。) 下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、 交付申請書に記載した「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600字~800字で、できる だけ分かりやすく記述すること。また、国立情報学研究所でデータベース化するため、図、グラフ等

本研究はエンジンのシリンダ内の燃焼圧力を直接検出する燃焼圧センサー材料の創成を目指し、ラン ガサイト(La<sub>3</sub>Ga<sub>5</sub>SiO<sub>14</sub>)型圧電結晶に着目している。最終年度である本年度は、これまで開発してきた ランガサイト型結晶におけるAI置換による結晶構造変化ならびに圧電特性変化について調べた。試料 にはチョクラルスキー法にて作製した単結晶を用いた。AI置換ランガサイト型結晶はLa<sub>3</sub>Ga<sub>5-x</sub>AI<sub>x</sub>SiO<sub>14</sub> 、La<sub>3</sub>Ta<sub>0.5</sub>Ga<sub>5.5-x</sub>Al<sub>x</sub>O<sub>14</sub>、La<sub>3</sub>Nb<sub>0.5</sub>Ga<sub>5.5-x</sub>Al<sub>x</sub>O<sub>14</sub>(それぞれLGAS*x*, LTGA*x*, LNGA*x*)の3種類を用意し、 各結晶は作製条件下で固溶限界までAIをドープさせた。結果、不純物を含まない単相としてLGAS0.9、 LTGA0.5, LNGA0.2の組成であるAI置換結晶が得られた。結晶構造解析として、イメージングプレー ト型回折計を用い回折強度を測定し、構造パラメータ精密化を行った。圧電特性評価には得られた結 晶を方位カットし、結晶基板を得、鏡面研磨を施した後、Au電極を形成したものを用いた。すべて の結晶において、置換したAIはLaが占有する十面体席以外の陽イオン席に分布し、その優先配位する 席は最小の四面体席、八面体席、四面体席の順であった。また、AI置換により室温における圧電定数 duが僅かに上昇することが分かった。圧電定数の温度依存性に関して、AI置換結晶とホスト結晶では 殆ど変わらず、室温から400℃までの温度範囲においてLTGA0.5結晶が最も変動が小さいことがわか った。また、抵抗率ー温度特性の測定では、As-grownのAl置換結晶の抵抗率がホスト結晶と比べ同温 度において10-30倍程度の抵抗率を有していることが分かり、ランガサイト型結晶へのAI置換が抵抗 率の上昇に有効であることを明らかにした。以上、本研究の成果よりLTGA0.5結晶が最も燃焼圧セン サー材料として有望であると結論づけた。

※ 成果の公表を見合わせる必要がある場合は、その理由及び差し控え期間等を記入した調書(A4 判縦長横書 1 枚)を 添付すること。

10.	キー	ワー	F
-----	----	----	---

(1)	固溶限界	(2) ドーピング	(3)	燃焼圧センサー
(4)	圧電結晶	(5) ランガサイ	F (6)	材料定数
(7)		(8)		(裏面に続く)

[雑誌論文] 計(4)件

著 者 名		論	文	標	題	
T. Kuze, <u>H. Takeda</u> , T. Nishida,	•	-		Alminum	Substituted 1	Langasite-type
K. Uchiyama and T. Shiosaki	$La_3Nb_{0.5}Ga_{5.5}O_{14}$	Single Crystals				
雑 誌 名	査読の有無		巻	発 行 年	最初と最後の頁	
Proc. Inter. Symp. Appl. F	無			2 0 0 7	594-595	

著 者 名	論	文 標	題	
Y. Yoneda, J. Mizuki, <u>H. Takeda</u> X-ray Top and T. Shiosaki method	ography on La <sub>3</sub> Ta <sub>0.5</sub> Ga	5.5O <sub>14</sub> Single	Crystal Grown	by Czochralski
雑 誌 名	査読の有無	巻	発 行 年	最初と最後の頁
Proc. Inter. Symp. Appl. Ferro. XVI	無		2 0 0 7	587-588

著 者 名	論	文 標	題	
Y. Yoneda, H. Takeda, T. Shiosaki, Difference in local	al and average	structures of	La <sub>3</sub> Ga <sub>5</sub> SiO <sub>14</sub>	crystal
J. Mizuki				
雑 誌 名	査読の有無	巻	発 行 年	最初と最後の頁
Jpn. J. Appl. Phys.	有	46	2 0 0 7	7163-7166

著 者 名	論	文 標	題	
H. Takeda, T. Kuze, T. Nishida, K. Growth and	piezoelectric pr	operties of	Al-substituted	langasite-type
Uchiyama and T. Shiosaki La <sub>3</sub> Nb <sub>0.5</sub> Ga <sub>5.5</sub> O <sub>1</sub> .	single crystals			
雑 誌 名	査読の有無	巻	発 行 年	最初と最後の頁
Mater. Res. Bull.	有		2 0 0 8	印刷中

# [学会発表]計(1)件

発 表 者 名		発 表	標 是	題		
武田博明、他3名	Al	l置換ランガサイト系	結晶の構造	造と圧電特性		
学 会 等 名		発表年月日		発 表	場所	Î
第55回応用物理学関係通	2008年3月27	日	日本大学理工学部	船橋キャ	ンパス	

## [図書] 計(0)件

著 者 名	出版	社	
	書 名	発 行 年	総ページ数
		1 1 1	

12. 研究成果による産業財産権の出願・取得状況

[出 願] 計(0)件

産業財産権の名称	発明者	権利者	産業財産権の種類、番号	出願年月日	国内・外国の別

# [取 得] 計(0)件

産業財産権の名称	発明者	権利者	産業財産権の種類、番号	取得年月日	国内・外国の別

#### 13. 備考

※ 研究者又は所属研究機関が作成した研究内容又は研究成果に関するwebページがある場合は、URLを記載すること。